⑫ 公 開 特 許公 報(A)

昭62-115440

Solnt Cl.4	識別記号	厅内整理番号		◎公開	昭和62年(1987)5月27日
G 03 C 1/71 C 08 L 25/18	LEK	8205 — 2 H 7602 — 4 J 7267 — 2 H	字本語士	李蓉士	発明の数 3 (全7頁)
G 03 C 1/00	3 1 1	. 1201 211	他且明小	ハロカハ	元为"数"。(至:入)

9発明の名称

ホトレジスト組成物およびt-置換オルガノメチルビニルアリール

エーテル材料

②特 頭 昭61-223978

②出 頭 昭61(1986)9月24日

侵先権主張

到1985年9月27日到米国(US)到780768

砂発 明 者

ジェームズ・ピンセン アメリカ

ト・クリベロ

ツク・カンパニイ

アメリカ合衆国、ニユーヨーク州、クリフトン・パーク、

カールトン・ロード、756番

⑪出 願 人 ゼネラル・エレクトリ

アメリカ合衆国、12305、ニユーヨーク州、スケネクタデ

イ、リバーロード、1番

邳代 理 人 弁理士 生沼 徳二

明 知 承

1. 発明の名称

ホトレジスト組成物および(一置換オルガノ メチルピニルアリールエーテル材料

- 2. 待許請求の範囲
- 1. (A)本質的に次式:

「式中のRは $C_{(1-8)}$ アルキル基および $C_{(6-14)}$ 、アリール基よりなる群から選ばれる一価の基で、 R^1 および R^4 は同じか異なる一価の $C_{(1-8)}$ アルキル基で、 R^3 は水梁および $C_{(1-3)}$ アルキルから選ばれる一価の基で、 R^4 は水梁、 $C_{(1-3)}$ アルキルおよびこれらの組合せから選ばれる一価

の基でR⁵ は同じか異なる $C_{(1-8)}$ アルキル基、 C1、Br、 NO_2 、CN、 $C_{(1-8)}$ アルコキシおよび $C_{(1-8)}$ アルキルエステルから選ばれ、 a は 0 - 2 に写しい C の化学結合単位よりなるポリスチレン、

- (B) 有効量のカチオン性光開始剤および
- (C) 成分(A) 1部当り10-95部の 不活性有限溶剤

を含むホトレジスト組成物。

- 2. 重合体が化学結合した4-t-ブトキシスチレン単位よりなる特許請求の範囲第1項記載のホトレジスト組成物。
- 3. 東合体が化学結合した4-t-ブトキシー α-メチルスチレン単位よりなる特許請求の範囲 第1項記載のホトレジスト組成物。
- 4. 光開始剤としてジアリールョードニウム塩 を用いる特許請求の範囲第1項記載のホトレジス ト組成物。
 - 5. 光開始剤としてトリアリールスルポニウム 塩を用いる特許剤状の範囲第1項記載のポトレジ

スト組成物。

6. 次式:

[式中のR は C (1-8) アルキル基および C (6-14) アリール基よりなる群から選ばれる一価の基で、 R^1 および R^2 は同じか異なる一価のC (1-8) アルキル基で、 R^1 は水紫および C (1-3) アルキルがら選ばれる一価の基で、 R^4 は水紫、C (1-3) アルキルおよびこれらの組合せから選ばれる一価の基で R^4 は同じか異なる C (1-8) アルキル基、 C^1 、 C^1 、 C^2 、 C^3 、 C^3 、 C^3 、 C^3 、 C^4 、

ルキル基で、 R^2 は水素および $C_{(1-3)}$ アルキルから選ばれる一価の基で、 R^4 は水素、 $C_{(1-3)}$ アルキルおよびこれらの組合せから選ばれる一価の基で R^5 は同じか異なる $C_{(1-8)}$ アルキル基、CI、Br、NO:、CN、 $C_{(1-8)}$ アルコキシおよび $C_{(1-8)}$ アルキルエステルから選ばれ、aは0 ー 2 に守しい〕の化学結合単位よりなる重合体。3 。発明の詳細な説明

発明の背景・

種々の感光性低合体を種々の光増感剤と和合せて用いて、紫外線照射時に低合体に架橋を起すことが行われており、このような低合体の例として、メリル(Merrill)が米国特許第2.948.610号でアジド亚合体を開示し、またミンスク(Minsk)が米国特許第2.725.372号でポリビニルアルコールの不飽和エステルを開示し、これらはそれぞれイーストマン・コダック社(Eastaan Kodak)のホトレジストKPRおよびKMERである。

イトウらの米国符許第4、 4 9 1, 6 2 8 号に、

7. 4-t-ブトキシスチレンである特許請求 の範囲気 6 項記載のアルケニルアリールエーテル。

8. 4-t-プトキシーローメチルスチレンである特許請求の範囲第6項記載のアルケニルアリールエーテル。

9.3-t-プトキシスチレンである特許請求 の範囲第6項記載のアルケニルアリールエーテル。 10.本質的に次式:

[式中のR はC $_{(1-8)}$ アルキル基お上びC $_{(6-14)}$ アリール基よりなる群から選ばれる一価の基で、R ! および R^2 は同じか異なる一価のC $_{(1-8)}$ ア

t - ブチルエステルや t - ブチルカーポネートな どの反復側基を有するポリスチレンのような重合。 体を光阴始剤と組合せて用いることが開示されて いる。紫外線に暴露すると酸が発生し、これがス チリルヒープチルエステルまたはスチリルヒーブ チルカーポネートを対応する塩基可溶性フェノー ルに転化する。地感剤の波果を変える地感剤をこ のホトレジストに加えることもできる。イトウら のポジまたはネガ型ホトレジスト組成物は従来の ホトレジストより著しく有利であるが、ポリーは - プトキシカルポニルオキシスチレンまたは対応 するポリーt-プトキシカルポニルオキシーα-メチルスチレンを紫外線に最高すると、二酸化炭 柔およびイソブチレンの両方、すなわち追測量の 気体状副生物が生成する。塩基水溶液に可溶な生 成物またはn-ヘキサンと塩化メチレンの混合物 に可溶な生成物に転化でき、しかも過剰量の気体 状副生物を発生しない、重合体材料を用いたポジ またはネガ型ホトレジスト組成物が行られれば型

本発明は、次式:

(1)
$$(R^{\dagger})$$
, $C = C$

$$R = C$$

$$R = R$$

$$R = R$$

【式中のRはC $_{(1-8)}$ T $_{N+1}$ $_{N+1}$

本発明によれば、

(A) 本質的に次式:

(3)
$$-C(R^4) = -C - R^3$$

$$R = 0$$

$$R = 0$$

$$R = 0$$

[式中のR、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 および R^5 および a は前記定義の通り]の化学結合単位よりなるポリスチレン、

- (B) 有効量のカチオン性光開始剤、および
- (C) 成分(A) 1部当り10-95部の不活 位有政治別

を含むホトレジスト組成物が促供される。

R、 R^{\perp} 、 R^{\perp} および R^{3} に含まれる一価のアルキル基は、例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシルであり、 R^{\perp} および

ルエーテルが重合でき、得られる重合体が有効はのアリールオニウム塩(後述)と組み合わせるとホトレジストとして使用できることを見出してなし、たものである。こうして得られるホトレジストは、次式:

【式中のR³、R⁴、R⁵ およびaは前記定義の通り】の化学結合単位を多数有するポジ型ホトレジストに転化することができる。本質的に式(2)の化学結合単位よりなる塩基可溶性低合体を生成する結果として、有利なことには、イソブチレンのような不飽和オレフィンが生成し、イトウらのホトレジスト法で生じる二酸化炭素のような気体状副生物を余分に発生することはない。

発明の概要

 R^4 に含まれる一価の基は、例えば、水煮またはR に含まれる $C_{(1-3)}$ アルキルである。そのほかにR はフェニル、トリル、キシリルまたはこれらの置換されたものとなり得、一方 R^5 はメトキシ、エトキシ、カルベトキシなどとなり得る。

本発明の実施にあたって使用できるカチオン性 光開始剤は、例えばジアリールヨードニウム塩で あり、具体例には下記のものがある。

アリールスルホニウム塩も含まれ、その具体例に は下記のものがある。

本発明の実施にあたって使用できる別のカチオ ン性光開始剤は、例えば次のものである。

光開始剤の有効量は、前述した成分(A)、(B) および(C) のホトレジスト組成物の全面量に基づいて0.5-20重量%の光開始剤である。

式 (1) に含まれる t - ブチルビニルアリール エーテルの具体例には次のものがある。

式 (1) のτープチルピニルアリールエーテル を本質的に式 (3) の化学結合単位よりなる重合 体に重合させるには、有効量の重合触媒、例えば 過酸化ペンソイル、2.2′-アソビスイソブチ ロニトリル、過酸化ラウロイル、過酸化ジクミル、 tープチルベルオキシピバレート、過酸化プロピ オニルなどを川いて重合を行うことができる。瓜 合触媒の有効量は、触媒と式 (1)の範囲内の t - プチルピニルアリールエーテルとの重量に基づ いて0. 1-5重量%の触媒である。式(1)の tープチルピニルアリールエーテルの亚合は、空 素や費ガスのような不活性容明気中で、不活性有 战洛州の存在下、25℃-180℃の範囲の温度 で行うことができる。不活性有機溶剤としては、 例えばペンゼン、トルエン、水、エタノール、シ クロヘキサン、キシレン、クロロベンゼン、ジメ チルホルムアミド、イソプロピルアルコールなど が適当である。

本質的に式 (3) の化学結合単位よりなる本発明のホトレジスト組成物と組合せて用い行る不活

式 (1) のセーブチルアリールピニルエーテル を製造する好適な方法は、例えば次の通りである。

性有限溶剂としては、例えば、1.2ージメトキシエタン、セロソルプアセテート、シクロヘキサノン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、クロロベンゼン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、塩化メチレン、1.2ージクロロエタン、ジオキサンなどが適当である。

本発明のホトレジスト組成物では、波長227-600nm(ナノメータ)の紫外線を用いた場合に、良好な結果が得られることを確かめた。しかし、場合によっては、電子ピームやX線も使用できる。ネが型ホトレジストが図ましい場合には、ホトレジストを通当な支持体に爆弾のスピンキャスト法で塗布し、照射して酸触媒を遊離させた後、希塩基水溶液の代りに有機溶剤の混合液、例えばローへキサンと塩化メチレンを用いることができる。

当菜者が本発明をうまく実施できるように、以下に実施例を限定としてではなく例示として説明する。 邵はすべて重量基準である。

突旋例 1

空来雰囲気下で激しくかきまぜながら、6.2.9 r(0.34モル)の4ークロロスチレンおよび250回の乾燥器留テトラヒドロフランを8.9 r(0.37モル)のマグネシウム金属切り間に、十分なテトラヒドロフランで切り屑をおおうようにして、補加した。発熱反応を外部冷却によ

物の構造と一致していた。

元素分析

計算面 (C₁₂H₁₆O) C 81.82%: H 9.09% 実測面 C 81.64%: H 8.89%

0.03 x の 2.2 ' - アソビスイソプチロニトリルを5 x の上記 4 - t - アントキシスチレンに溶解した溶液を、空素でパージした後、容器 時間別した。混合液をを対条件下で70 でに18 時間別無した。固形物が得られ、これを塩化メチレンに溶解し、メタノールで洗い、減圧下80 でに溶解し、メタノールで洗い、減圧下80 でで1、2 時間乾燥した。4.76 x の生成物がおてで1、2 時間乾燥した。4.76 x の生成物がおこれは収出95.2%であった。 刻造せていおよび塩化メチレン中での CPC分析に基づいたよび塩化メチレン中での CPC分析に基づいたよび塩化メチレン中での CPC分析に基づいたよび、これは収出95.2%であった。 200 のボリー 4 - t - アトキシスチレンであった。この重合体のガラスに移過度は103でであった。

买施例 2

実施例1の手順を接返したが、本例では16.

り制御して温度を60℃以下に保った。発熱がや んだ後、反応混合物を60℃に0.5時間、マグ ネシウムの大部分が消費されるまで加熱した。 塩 - 水浴を用いて反応混合物を 0 てに冷却し、 4 4 g(0.23モル)のt-ブチルパーペンソエー トを80回のテトラヒドロフランに溶解した溶液 を温度を 0 でー 5 での間に維持するような速度で 加えた。添加完了後、かきまぜながら2時間にわ たって温度を25でまで上昇させた。次に反応湿 合物を1000回の3%塩酸に注入した。生成し た油を200回のエチルエーテルで数回、水溶液 から抽出した。エーテル層を10%水酸化ナトリ ウム水溶液で2回洗い、次いで水で、洗液が中性 になるまで洗った。次にエーテル層を破棄ナトリ ウム上で乾燥し、回転エパポレータを用いてエー テルを除去した。残った黄白色の油に少量のアイ オノールを禁止剤として加え、生成物を分別器部 した。沸点が45-46℃/0.03mmである4 ー t ープトキシスチレンを収半20%で得た。プ ロトンNMRスペクトルを記録した。これは生成

4-t-ブトキシーα-メチルスチレンのカチオン正合を、窒素容囲気中の密封条件下で、3.5 cの4-t-ブトキシーα-メチルスチレン、1 mの1.2-ジクロロエタンおよび0.0 4 cの4-メトキシジフェニルヨードニウム ヘキサフルオロホスフェートで行った。混合物を-28

てから-50でに冷却し、450フットのハノビア (Nanovia) 中圧水銀アークランプを用いて1時間照射した。照射後、精関な頂合体混合物を一30でで0.5時間が関し、次いでメタノール中で沈澱させた。頂合体を沪退し、メクノールで洗い、次いで真空下で乾燥し、Mn - 10.173 メノモルおよびMw - 15.495 メノモルのポリー4 - ブトギシーαーメチルスチレン0.8 メを得た。

实施例 3

災施例1をすべての点について短返したが、本例では4-クロロスチレンの代りに3-プロモスチレンを用いた。3-t-プトキシスチレンである生成物を分別法留により箱製し、沸点50-52で/0.05mの純粋な単量体を次の近合に用いた。0.36 gの2.2′-アソビスイソブチロニトリルと15.0 gの3-t-ブトキシスチレンの混合物を窒素下で重合フラスコに密封した。 亜合を70で18時間行った。重合体を実施例1に記載した通りに単離した。

0. 5 gのポリー4ーtーブトキシスチレン、
0. 2 gのジ(4ーtーブチルフェニル)ョード
ニウム ヘキサフルオロアンチモネート、 0. 0
0 3 7 gのペリレンおよび 5 mlのグライムを含有
するホトレジスト溶液を型造した。この溶液を正
径 4 インチのシリコンウェーハにスピンコートし、
1 0 0 で 3 0 分間焼付けた。多重密度マスク付
きのパーキン・エルマー(Perkin Elacr) 1 1 1
投影アライナを用いてウェーハを配光した。 nー
ヘキサンとクロロホルムの 3 : 1 混合液を用いて、
ウェーハをネガモードで現像した。 走査速度 3 2
0 で最良の結果が得られた。 1. 5 μα までのラインを解像し、 2. 5 μα のラインで解像反反好
であった。

上述した実施例は、ホトレジスト組成物をマスクするのに用い得る極めて多数の変数ならびにアルケニルアリールエーテルおよびそれから得られる重合体のごく一部に関するものであるが、 本館明は、実施例に先立つ説明からわかるように、 はるかに広い範囲のホトレジスト組成物ならびにこ

实施例 4

0.5 gのポリー 4 ー l ー ブトキシスチレン、
0.1 gのジ (l ー ブチルフェニル) ヨードニウム トリフルオロ 4 タンスルホネートおよび 7 回のグライムよりなる流液を、数個の山径 3 インチのシリコンウェーハにスピンコートした。次にウェーハを 100 でで 30分間焼付け、次に金属技点材および G E H 3 T 7 中圧水銀アークランプを用いてブリントした。 2 秒間の照射後、100で5 秒間の後焼付けを行った。ウェーハを 1.6 N NaOHに 1 分間没済することによりウェーハを現像した。鮮明な輪郭のはっきりしたボジィメージが得られた。

ボリー4ーtープトキシーαーメチルスチレンに基づくホトレジストを用いて、上記と同じ手順を繰返した。最初にシリコンウェーハを5秒間照射し、100で10秒間の後娘付けをし、1.6N NaOHで1分間現像することにより、ボジトーンのイメージが得られた。

灭施例 5

の組成物の製造に用いるアルケニルアリールエー テル材料に関することを理解すべきである。

特許出版人

ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 代理人 (7630) 生 招 急 二